

*Preferred device
Dispositif recommandé

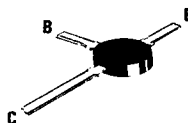
The ESM 379 is a low noise high current transistor with very good signal handling capability. It is intended for use as input amplifier in large signal TV tuners with PIN diodes AGC.

L'ESM 379 est un transistor fort courant à faible bruit admettant un signal d'entrée de niveau élevé.

Il est destiné à l'étage d'entrée des sélecteurs de canaux TV à grande dynamique avec CAG à diodes PIN.

F 5 dB à $I_C = 8$ mA
 $f = 800$ MHz
G_p 18 dB à $I_C = 8$ mA
 $f = 800$ MHz

Plastic case CB-146 — See outline drawing on last pages
Boîtier plastique Voir dessin coté dernières pages



Weight : 0,11 g.
Masse

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

T_{amb} = +25 °C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Collector-base voltage Tension collecteur-base	$I_E = 0$	V_{CBO}	-20	V
Collector-emitter voltage Tension collecteur-émetteur	$I_B = 0$	V_{CEO}	-13	V
Emitter-base voltage Tension émetteur-base	$I_C = 0$	V_{EBO}	-3	V
Collector current Courant collecteur		I_C	-20	mA
Power dissipation Dissipation de puissance	T _{amb} ≤ 45°C	P _{tot}	170	mW
Junction temperature Température de jonction	max	T _j	150	°C
Storage temperature Température de stockage	min max	T _{stg}	-55 +150	°C

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
 $T_{amb} = 25^{\circ}C$ (Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

	Test conditions <i>Conditions de mesure</i>			Min. Typ. Max.	
Collector-base cut-off current <i>Courant résiduel collecteur-base</i>	$V_{CB} = -10 V$ $I_E = 0$	I_{CBO}		-100	nA
Collector-base breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-base</i>	$I_C = -100 \mu A$ $I_E = 0$	$V_{(BR)CBO}$		-20	V
Collector-emitter breakdown voltage <i>Tension de claquage collecteur-émetteur</i>	$I_C = -5 mA$ $I_B = 0$	$V_{(BR)CEO}$		-13	V
Emitter-base breakdown voltage <i>Tension de claquage émetteur-base</i>	$I_E = -10 \mu A$ $I_C = 0$	$V_{(BR)EBO}$		-3	V
Static forward current transfer ratio <i>Valeur statique du rapport de transfert direct du courant</i>	$V_{CE} = -10 V$ $I_C = -8 mA$	h_{21E}		20	

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

Transition frequency <i>Fréquence de transition</i>	$V_{CE} = -10 V$ $I_C = -8 mA$ $f = 100 MHz$	f_T		1,2	GHz
Output capacitance <i>Capacité de sortie</i>	$V_{CB} = -10 V$ $I_E = 0$ $f = 1 MHz$	C_{22b}		0,6	pF
Noise figure <i>Facteur de bruit</i>	$V_{CB} = -10 V$ $R_G = 50 \Omega$ $I_C = -8 mA$ $f = 800 MHz$	F		5	dB
Power gain <i>Gain en puissance</i>	$V_{CB} = -10 V$ $I_C = -8 mA$ $R_L = 2 k\Omega$ $f = 800 MHz$	G_P		18	dB

THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-ambient thermal resistance <i>Résistance thermique (jonction-ambiante)</i>		$R_{th(j-a)}$		600	$^{\circ}C/W$
--	--	---------------	--	-----	---------------